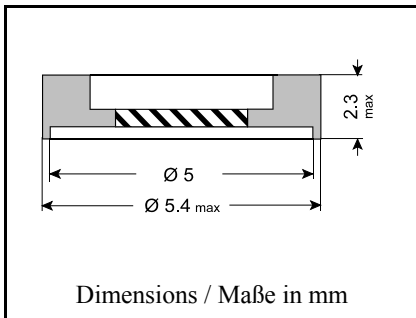


**Silicon Rectifier Cells
with polysiloxan passivation**

**Silizium-Gleichrichterzellen
mit Polysiloxan-Passivierung**



Nominal current – Nennstrom 3 A
 Repetitive peak reverse voltage 50...1000 V
 Periodische Spitzensperrspannung
 Weight approx. – Gewicht ca. 0.3 g
 Standard packaging bulk
 Standard Lieferform lose

Maximum ratings and Characteristics

Kenn- und Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
AG 3A	50	80
AG 3B	100	130
AG 3D	200	250
AG 3G	400	450
AG 3J	600	700
AG 3K	800	1000
AG 3M	1000	1300

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last	$T_T = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	3 A ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	30 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	150 A
Rating for fusing – Grenzlantintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	110 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	$-50...+150^\circ\text{C}$ $-50...+150^\circ\text{C}$
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 3\text{ A}$	$V_F < 1.2\text{ V}$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R < 10\ \mu\text{A}$

¹⁾ Max. temperature of the terminals $T_T = 100^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur der Kontaktflächen $T_T = 100^\circ\text{C}$